

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

диоды полупроводниковые

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

FOCT 17465-80

Издание официальное

ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

17465-80

Основные параметры

Semiconductor diodes. Basic parameters

FOCT 16963-71 N FOCT 17465-72 в части пп. 1—12, 16—22

гост

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 августа 1980 г. № 4471 срок введения установлен c 01.01.82

Несоблюдение стандарта преспедуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модериизируемые полупроводниковые диоды: выпрямительные (кроме диодов Шоттки), импульсные, стабилитроны (стабисторы), варикавы, диоды СВЧ, выпрямительные столбы и импульсные диодные матрицы (сборки).

Стандарт устанавливает ряды и допускаемые сочетания значений основных параметров, которые в табл. 1-17, отмечены

знаком «+».

Допускаемые сочетания, отмеченные знаком «×» в табл. 1—11, 15-17, предназначены для применения в устройствах специального назначения.

Приведенные в стандарте числовые значения параметров устанормальных климатических условий по ГОСТ 16962-71.

Пояснения к терминам приведены в справочном приложении.

2. Основные параметры выпрямительных диодов.

2.1. Допускаемые сочетания значений основных параметров выпрямительных диодов должны соответствовать указанным табл. 1.

Издание официальное

Перелечатка воспрещена

Переиздание. Сентябрь 1983 г.

Постоянный примой или средний		Постоя	вичос об	ратное	наприж	ение, В	
прямой ток, А	100	200	100	600	800	1000	1500
0,10 0,30 0,50 0,70 1,00 3,00 5,00 7,00	+ + + + + + + X	++++++X	+×++×+×+×	+++++++++	*******	++++++++	X+X+X+X+

2.2. Значение предельной рабочей частоты должно выбираться

из ряда: 1; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 кГц.

2.3. Значение мощности импульсных перегрузок по обратному току для выпрямительных диодов должно выбираться из ряда: 200; 1 000; 2 000; 5 000; 20 000; 50 000 Вт.

3. Основные параметры выпрямительных столбов

З.1. Допускаемые сочетания значений основных параметров выпрямительных столбов должны соответствовать указанным в табл.

Таблица 2

		Инпул	ьсное о обратно	братное е капряз	или пос кение, л	тояниое В	
Постоянный прамой или средний прямой ток, мА	2	4	6		10	15	20
10 30 100 300 500 1000	++×+×+	+++++	×+×+××	++++++	×+×+××	+++++	×+×+×+

3.2. Максимальное значение частоты выпрямления выпрямительных столбов должно выбираться из ряда: 1; 5; 10; 20; 50; 100; 200: 500 кГи.

4. Основные параметры импульсных диодов

4.1. Допускаемые сочетания значений основных параметров импульсных диодов должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3

Carrent approx		Время	я восста	повлени	я обрат	иого со	противае	иня, не	
Средана прямой ток, мА	0,20	0,50	1,00	4,00	10,00	10,00	100,00	400,00	1000,00
2 5	×	++	+	+	+++	++	++	++	++
10 20 50	+×+×-	++×+	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++	++++	++++	+++	++++	+++
100 200 500	×+	+	+	1	+	+	+	+	1 ‡

Примечание. Приборы с большим быстродействием характеризуются временем жизни неравновесных носителей заряда, которое выбирается из ряда: 0.01; 0.02; 0.05; 0.10 жс.

4.2. Значение постоянного обратного напряжения импульсных диодов должно выбираться из ряда: 3; 5; 10; 20; 30; 50; 100; 200 В.

 Допускаемые сочетания значений основных параметров стабилитронов (стабисторов) общего назначения должны соответствовать указанным в табл. 4.

Таблица 4

Допускаемая рассепвасмая				Номи	вады	ioe ma	пряж	ение -	стаби	песи	ня, В	_	_	_
мощность, Вт	0,7	1,4	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3.6	3,9	4,3	4,7	5,1	5,6
0,020 0,050 0,125 0,300 1,000 2,000 5,000 10,000	X+++++++	++++++×+	++++++++	+++X++++	+++++++	+++++++	++++++++	++++++++	+++++++	+++×++++	+++++++	++++++	++++++×+	+++++++

Допускаеман рассепвиеман				Номн	налы	юе на	пряже	сине (табил	COL3 BUILD	и, В			
мощность, Вт	6,2	6,8	7,5	8,2	9,1	10,0	11,0	12,0	13,0	1000	16,0	(8,0	20,u	22,0
0,020	+	+	+	+	+	+	+	×	+	+	+	+	+	×
0,050 0,125	1	1	1	1	1	1	+	#1	#1	X	+	+	+	T
0,300	+	×	+	+	土	+	+1	+ ×	+1	+	# 1	+	+	X
2,000	11	11	1	+	+	1	TI	7	71	71	71	Ŧ 1	Ŧ!	+
5,000	1+	+	+	+	+	+	+1	J. I.	+	+1	+	+ 1	7	×
10,000	-	l t	+	+ 1	X	+ (+ 1	XI	+1	+ 1	+ 1	71	+ 1	1

Примечания:

- Значения номинального напряжения стабилязации более 22 В выбирают умножением ряда напряжений от 2,4 до 22 В на 10 и 100.
- 2. Допускаемое откловение номинального напряжения стабилизации должно соответствовать значениям: $\pm 5;~\pm 10\%$
- Допускаемые сочетания значений основных параметров прецизионных стабилитронов должны соответствовать указанным в табл. 5.

Таблица 5

Torrespond to the same of the	Знач	кение вр	енеяной стаб	нестаб (идизако	ижьності ін. %	в напри	кения
Температурный коэффицисит шапряжения стабилизации	0,0005	0,0010	0,0020	0.0050	0,0100	0.0200	0.0600
0,0002 0,0005 0,0010 0,0020 0,0050	×+×+	++++×	++++	+++X	+++++	++++	++++

7. Основные параметры варикапов

 7.1. Допускаемые сочетания значений основных параметров варикапов при обратном напряжении 6 В должны соответствовать указанным в табл. 6.

Таблица 6

Добротность					Номян	альна́ в	емкос	ть, пФ				
на частоте. 50 МГц	1,0	1,2	1,5	1,8	2,2	2,7	3,3	3,9	4.7	3,6	6.8	8,9
100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2000 2200	++	+++	++++	+ + + + + +	++++++	++++++	+++++++	++++++++	++++++++	+++++×+++	++++++++	++++×+++

Допускаемое отклонение емкости должно быть в пределах ±20% номинального значения.

7.2. Допускаемые сочетания значений основных параметров подстроечных варикапов при обратном напряжении 4 В должны соответствовать указанным в табл. 7 и 8.

Таблица 7

Добротность				Номя	пальная	енкост	ь, пФ			
на частоте 30 МГа	10	12	15	18	22	- 27	33	39.	47	56
150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000	++++X++++++	++++++++++	+++X+++++++	+++++++++++	++×+++++++	+++++++++	+++++++	+×++++	+++++	++×+

Допускаемое отклонение емкости должно быть в пределах $\pm 20\%$ номинального значения.

Добротность		i.			ŀ	IONHIS	пльная	емност	ть, пФ				
на частоте 30 МГц	68	100	120	150	150	220	270	330	390	470	560	630	10:0
150 200 250 300 400 500 600	++++×++	++++++	+++×++	++++×+	++++	++++	+ + * *	++++	++++	+++×	++++	×	+

 Допускаемые сочетания значений основных параметров настроечных СВЧ диодов должны соответствовать указанным в табл. 9.

Таблица 9

Доброт- вость на			Hos	сина.	льна	я сы	кост	e ng	и ос	рат	ion	напр	яже	виж	мину	rc 6	В. г	1Φ	
частоте 1 ГГц	0,08	0,10	0,15	0.20	0,25	0,34	0,48	0,60	0,80	1.20	1.86	2,20	2.7	3,30	3,90	4,70	5,60	6,90	8,20
20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 180 220 260 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400	++++++×	++++++++	++++++++++++	++++++++++++	++++++++×	++++++++++	++++++++	++++++++X	++++++++++	++++++++X	++++++++++	+++++++X	+++++++++	++++++++++	#	++++++++++	+++++++++X	+++++++++	+++++++X+

Примечание. Допускаемый разброс номинальной емвости диода выбирается из ряда: $\pm 5;\;\pm 10;\;\pm 20\%.$

9. Основные параметры смесительных СВЧ диодов

 9.1. Допускаемые сочетания значений основных параметров смесительных СВЧ диодов должны соответствовать указанным в табл. 10.

Таблица 10

Норинрованный коэффициент		д	MHEOR CHES	измерения,	CN	
шума, дБ. на промежуточной частоте 30 МГц	0,1	0.2	0.4	0,8	2,6	3,2
4,5 5.0	+ *	+ ×	×	×	+ ×	×
4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0	X++++	+	+	+	× + +	++++
6,5 7.0	+	+	+	+	+	1
7,5	+	+	+	4	1 7	
8,0 9.0	1 ‡	+	+	-		
10,0	+	1	+			
11,0 12,0	+	‡				
14.0	+	7				

 9.2. Минимальная энергия выгорания должна выбираться из ряда; 0,10; 0,25; 0,50; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0; 15,0; 20 эрг.

10. Основные параметры детекторных СВЧ днодов

 Допускаемые сочетания значений основных параметров детекторных СВЧ диодов должны соответствовать указанным в табл. 11.

Таблица 11

Тангенциальноя		д	лина водиы	измерения,	см	
чуветвительность, дВ · мВт	0.1	0.2	0.4	0.8	2.0	3,2
44	×					
44 46 48 50 52	+	1 ‡	X			
50	+	+	+	+		
52	+	+	+	+	×	
54 56 58 60	+	+	1 +	. +	+	١.
50	T	+	I +	1 7		1 5
60	I	1 7	I I	II	II	1 소
62	1	1	II	II	II	I I

10.2. Минимальная импульсная СВЧ рассеиваемая мощность должна выбираться из ряда: 0,025; 0,05; 0,10; 0,25; 0,5; 1,0; 2,5; 5 Вт.

11. Основные параметры параметрических СВЧ диодов

11.1. Допускаемые сочетания значений основных параметрических диодов должны соответствовать указанным в табл. 12.

Таблица 12

Постоянняя времени ври наприжения	Емкость перехода при напряжения
смещения минус 2 В, ис	смещения 0, пФ
0,10* 0,12 0,16 0,20 0,25* 0,30 0,40 0,50* 0,60 0,80 1,00	0,010,015* 0,010,04 0,010,06 0,010,30 0,010,40* 0,010,50 0,010,60 0,010,70* 0,010,80 0,040,80 0,040,80 0,101,00

 Предназначены для применения в устройствах специального назначения. Примечание. Допускаемый разброс емкости перехода диода одного типа выбирается из ряда: ±5; ±10; ±20; ±50; ±100%.

11.2. Значение постоянного обратного напряжения при нормированном токе параметрических СВЧ диодов должно выбираться из ряда: 4; 6; 8; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60 В.

12. Основные параметры СВЧ умножительных диодов

12.1. Допускаемые сочетания значений основных параметров умножительных СВЧ диодов должны соответствовать указанным в табл. 13.

Таблица 13

Допускаемая рассеннаемая мощность, Вт минус 6 В.		Допускаемая рас- сенваемая мощность, Вт	Емкость перехода при наприжении смещения минус 6 В, пФ		
0,010* 0,016 0,025 0,040 0,060 0,100 0,160	0,03-0,05* 0,04-0,06 0,05-0,08 0,06-0,12 0,08-0,20 0,10-0,30 0,10-0,60	0,250* 0,400 0,500 0,600 0,800 1,000*	0,10—1,25* 0,12—2,00 0,12—2,20 0,15—2,50 0,15—3,20 0,20—4,00*		

Продолжение табл. 13

Допускаемая рас- с-няземая мощность, Вт	Емкость перехода при папряжении смещемия минус 6 В. пФ	Допусьземая рас сеяваемая мощность, Вт	Емкость пенеход; при папряжения смещения минус в В, пФ		
2,000	0,50-6,00	8,000	3,00- 8,00		
3,000	3,000 1,00-8,00		4,00-10,00		
4,000	1,25-8,00	16,000	5,00-10,00		
5,000*	1,60-8,00*	25,000	6,00-10,00		
6,000	2,00-8,00	40,000*	8,00-10,00*		

[•] Предназначены для применения в устройствах специального назначения.

Првиечание. Допускаемый разброс емкости перехода лиода одного тила выбирается из ряда: $\pm 5;\ \pm 10;\ \pm 20;\ \pm 50;\ \pm 100\%$.

12.2. Значение предельной частоты умножительных СВЧ диодов выбирается из ряда: 40; 60; 100; 150; 200; 250; 320; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 2500; 3000 ГГд.

13. Основные параметры ограничительных СВЧ диодов

 Допускаемые сочетания значений основных параметров ограничительных СВЧ диодов должны соответствовать указанным в табл. 14.

Табляца 14

Накопленный заряд, иКл	Енкость структуры, пФ	Пакопленный заряд, пКл	Емкость структурм, пФ
. 0.1*	*1,0-10,0	10,0	0,20- 6.00
0,3	0,01-0.2	15,0	0,40-10,00
0,5	0,05-0,3	20,0	1,00-10,00
1,0	0,10-0,60	25.0	1,60-10,00
3,0	0,10-1,60	30.0*	2,50-10,00*
5,0*	0,10-4,00*		

Предназначены для применения в устройствах специального назначения.

14. Основные параметры переключательных СВЧ диодов

 Допускаемые сочетания основных параметров СВЧ переключательных диодов должны соответствовать указанным в табл. 15.

^{13.2.} Допускаемая рассенваемая мощность ограничительных СВЧ диодов должна выбираться из следующего ряда: 0,1; 0,15; 0,25; 0,40; 0,60; 1,0; 1,5; 2,5 Вт.

- 14.2. Значение критической частоты переключательных СВЧ диодов должно выбираться из ряда: 20; 40; 60; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1200; 1500 ГГп.
- 14.3. Допускаемый разброс номинальной емкости диода одного типа выбирается из следующего ряда: $\pm 5;~\pm 10;~\pm 20;~\pm 50;~\pm 100\%$.
 - 15. Основные параметры импульсных диодных матриц
- 15.1. Допускаемые сочетания значений основных параметров импульсных диодных матриц должны соответствовать указанным в табл. 16.

Средний			. 1	Зостоян	яое обра	тиое на	пряжен	se, B		
прямой ток. нА	2	3	5	10	20	50	40	50	60	75
0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 100 150 200 300 400 500	+++++	++++++++	+X++++++++++++++++++++++++++++++++++++	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	X:++++++++++++	+++X++++++X	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	++++×+++×

Табляца 16

15.2. Значение времени восстановления обратного сопротивления импульсных диодных матриц должно выбираться из ряда: 0,01; 0,02; 0,05; 0,10; 0,20; 0,50; 1,00; 4,00; 5,00; 10,00; 20,00; 40,00; 100,00; 400,00; 1000,00 нс. При этом должно соблюдаться соотношение

$$I_{\rm np, \ u. \ max} > (5-10)I_{\rm np, \ max}$$

где $I_{\rm np,\; H,\; max}$ — максимально допускаемый импульсный прямой ток;

Іпр. так — максимально допускаемый постоянный прямой ток.

 Допускаемые сочетания значений основных нараметров лавиню-пролетных днодов для усиления и генерирования электрических сигналов СВЧ должны соответствовать указанным в табл 17.

Таблица 17

	Дианазон рабочих частот, ГГц							
Выходная мещность, Вт	8-14	12-15	17-18	20- 22	24-26	30 37	4550	UO -70
0,02—0,03 0,04—0,05 0,08—0,10 0,15—0,30 0,40—0,50 0,80—1,00 1,50—2,50 3,00—4,50 5,00—7,00 8,0—12,00 15,0—20,0 25,0—40,0	+++++++X	+++++++	+++++	X+++++++	4++++X	X+++++	++++	++ ×

Примечания:

Значения монциости от 0,02 до 7,0 Вт даны для непрерывной, а от 8,0 до 40,0 Вт — для импульсной мощности.

 В интервале от 70 до 300 ГГц диапазон рабочих частот и выходиая мощность устанавливаются в стандартах и технических условиях на приборы конкретных типов.

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

Пояснения к терминам, относящимся к нестандартизованным наименованиям групп приборов

Термия	Пожененые		
Настроечный полупроводинко- вый СВЧ диод	СВЧ полупроводниковый диод, предна- значенный для настройки СВЧ цепей		
Импульсная диодная матрица	Совокупность полупроводниковых им- пульсных диодов, собранных в единую конструкцию, не соединенных электрическа или соединенных по одновменным выводам		
Прецизновный стабилитрон	Термокомвененрованный стабилитрон с fарантированной временной нестабиль- ностью		

 Редактор В. Н. Шалаева
 Технический редактор Л. В Вейнберг Корректор Э. В. Митяй

Сдане в наб. 22.02.84 Подп. в всч. 25.06.84 і,0 п. л. і,0 усл. кр.-отт. 0.81 уч.-изд. д. Тираж 6000 Цена Б коп.